

Neue Produkte __ 1-MBit-FRAM für Spannungen ab 2 V

01.10.2008

Als erstes Mitglied seiner V-Familie kündigt **Ramtron** den FRAM-Baustein FM25V10 an. Dieser nichtflüchtige Speicher mit 1 MBit Kapazität und SPI-Schnittstelle ist für eine Betriebsspannung von 2,0 bis 3,6 V ausgelegt.

Er führt Schreiboperationen ohne Verzögerung mit Busgeschwindigkeit durch und erreicht eine Lebensdauer von 100 Billionen Schreib-/Lesezyklen. Neben der Device-ID mit Angaben zu Hersteller, Kapazität und Revisionsnummer kann der Baustein mit einer eindeutigen Seriennummer versehen werden.

Der FM25V10 arbeitet im industriellen Temperaturbereich von -40 bis +85 °C mit einer Stromaufnahme von 3 mA bei 40 MHz SPI-Takt. Im Standby reduziert sich die Stromaufnahme auf 90 µA und im Sleep-Modus auf 5 µA. Muster sind im achtpoligen SOIC-Gehäuse verfügbar. (dar) • FM25V10

Ramtron

Elektronik Informationen

Sonnenstraße 4

80331 München

Telefon: 089/5 48 84 29-0

Telefax: 089/5 48 84 29-9

Email: elektronikinformationen@at-fachverlag.de

Copyright 2006 AT-Fachverlag GmbH - www.at-fachverlag.de